

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專訴字第37號

原告 黃秀媛
訴訟代理人 黃世瑋律師
輔佐人 詹偉鴻
被告 超越群科技有限公司
兼法定代理人 周文禮
被告 費西產品設計研發有限公司
兼法定代理人 陳冠名
共同
訴訟代理人 林冠佑律師
輔佐人 詹豐隆

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國113年7月18日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

按智慧財產案件審理法民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定，112年1月12日修正、同年8月30日施行之智慧財產案件審理法第75條第1項前段定有明文。本件係智慧財產案件審理法修正施行前即111年1月6日繫屬於本院，此有民事起訴狀上本院收狀章在卷為佐（見本院卷一第13頁），是本件應適用修正前之規定，合先敘明。

乙、實體方面：

壹、原告主張：

一、原告為中華民國發明專利證書第1630405號「雷射干擾器」專利（下稱系爭專利1）、中華民國發明專利證書第1630406號「雷射干擾器」專利（下稱系爭專利2，與系爭專利1合稱

系爭專利)之專利權人。原告於110年1月間發現訴外人康璿
科技有限公司(下稱康璿公司)所銷售之「南極星HP-3 PLU
S雷射二極體防護罩」產品(下稱系爭產品1)有侵害系爭專
利權之虞。進行專利比對後,發現系爭產品1具有系爭專利1
請求項1之技術特徵,而對系爭專利1請求項1至7、11至13構
成文義侵權,對請求項8、10構成均等侵權。且系爭產品1亦
有系爭專利2請求項1之技術特徵,而對系爭專利2請求項1至
3、5、6、9至11、13、14構成文義侵權,對請求項4、7、
8、12、15構成均等侵權。嗣經原告詢問得知系爭產品1係被
告費西公司製造並出貨與康璿公司。又被告費西公司製造由
被告超越群公司販賣之系爭產品2、被告費西公司製造由康
璿公司販賣之系爭產品3(與系爭產品1、2,合稱系爭產
品),經原告進行侵害鑑定比對,發現系爭產品2對系爭專利
1請求項1至7、11至13構成文義侵害、對請求項8、10構成均
等侵害;對系爭專利2請求項第1至3、5、6、9至11、13、14
構成文義侵害,對請求項4、7、8、12、15構成均等侵害;
系爭產品3落入系爭專利1請求項1至7、11至13之文義範圍,
請求項8、10之均等範圍;系爭產品3落入系爭專利2請求項1
至3、5、6、9至11、13、14之文義範圍、請求項4、7、8、1
2、15之均等範圍。綜上,原告爰依專利法第96條第1、3
項、民法第185條、公司法第23條規定,對被告等請求排除
侵害暨連帶損害賠償,並銷毀侵害系爭專利之系爭產品。

二、並聲明:

- (一)被告超越群公司不得自行或使第三人為製造、販賣、為販賣
之要約、使用或基於上述目的而進口系爭產品1、2之行為;
被告費西公司不得自行或使第三人為製造、販賣、為販賣之
要約、使用或基於上述目的而進口系爭產品1至3之行為。
- (二)被告超越群公司應將其販賣、為販賣要約之系爭產品1、2全
數回收並銷毀;被告費西公司應將其製造、販賣之系爭產品
1至3全數回收並銷毀。

01 (三)被告費西公司、陳冠名應連帶給付原告100萬元，暨自本起
02 訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利
03 息。

04 (四)被告超越群公司及費西公司，或被告超越群公司及周文禮，
05 或被告費西公司及陳冠名應連帶給付原告100萬元，暨自本
06 起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之
07 利息。如其中一被告為給付，其餘被告免除給付之義務。

08 (五)訴訟費用由被告等負擔。

09 (六)就上開訴之聲明第三項、第四項，原告願供擔保，請准宣告
10 為假執行。

11 貳、被告等則以：

12 一、系爭產品均未落入系爭專利之文義範圍：

13 依原告所提鑑定報告，無法確認係經由具有專業資格之鑑定
14 機關之人所做成，且其檢測方法亦無法確認系爭諸產品與系
15 爭二專利間之差異，因而無法證明系爭諸產品確實侵害系爭
16 二專利。又被告等於系爭專利申請前，於我國實施系爭專利
17 之技術，並用於系爭產品之先前產品，符合專利法第59條第
18 1項第3款先使用權抗辯規定。

19 二、系爭專利均不具進步性：

20 針對系爭專利1而言，被證2、3之組合足以證明系爭專利1請
21 求項1、6不具進步性，被證2、3、6之組合足以證明系爭專
22 利1請求項2至5、11至13不具進步性，被證1至3之組合足以
23 證明系爭專利1請求項7不具進步性，被證1、2、3及6之組合
24 足以證明系爭專利1請求項8、10不具進步性。針對系爭專利
25 2而言，被證2、3、6及7之組合足以證明系爭專利2請求項1
26 至7、9至15不具進步性，被證1、2、3、6及7之組合足以證
27 明系爭專利2請求項8不具進步性。

28 三、並聲明：

29 (一)原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

30 (二)訴訟費用由原告負擔。

31 (三)如受不利判決，被告願供擔保請准宣告免為假執行。

參、兩造不爭執事項：(本院卷四第467至468頁，並依本院論述與妥適調整文句)

一、原告為系爭專利1之專利權人。系爭專利1申請日為106年4月13日，公告日為107年7月21日，專利權期間126年4月12日止。

二、原告為系爭專利2之專利權人。系爭專利申請日為106年4月13日，公告日為107年7月21日，專利權期間126年4月12日止。

三、被告費西公司開發、設計、製造系爭產品1。

四、被告費西公司開發、設計、製造系爭產品2，並供貨由被告超越群公司販售。

五、被告費西公司開發、設計、製造系爭產品3。

肆、本件爭點：(本院卷五第87至90頁、本院卷六第394頁，並依本院論述與妥適調整文句)

一、專利侵權部分：

(一)系爭產品1是否落入系爭專利1請求項1至7、11至13文義範圍？是否落入系爭專利1請求項8、10均等範圍？

(二)系爭產品1是否落入系爭專利2請求項1至3、5至6、9至11、13至14文義範圍？是否落入系爭專利2請求項4、7至8、12、15均等範圍？

(三)系爭產品2是否落入系爭專利1請求項1至7、11至13文義範圍？是否落入系爭專利1請求項8、10均等範圍？

(四)系爭產品2是否落入系爭專利2請求項1至3、5至6、9至11、13至14文義範圍？是否落入系爭專利2請求項4、7至8、12、15均等範圍？

(五)系爭產品3是否落入系爭專利1請求項1至7、11至13文義範圍？是否落入系爭專利1請求項8、10均等範圍？

(六)系爭產品3是否落入系爭專利2請求項1至3、5至6、9至11、13至14文義範圍？是否落入系爭專利2請求項4、7至8、12、15均等範圍？

(七)被告等可否主張專利法第59條第1項第3款之先使用權抗辯？

01 二、專利有效性部分：

02 (一)系爭專利1：

03 1.被證2、3之組合是否足以證明系爭專利1請求項1、6不具進
04 步性？

05 2.被證2、3及6之組合是否足以證明系爭專利1請求項2至5、11
06 至13不具進步性？

07 3.被證1、2及3之組合是否足以證明系爭專利1請求項7不具進
08 步性？

09 4.被證1、2、3及6之組合是否足以證明系爭專利1請求項8、10
10 不具進步性？

11 (二)系爭專利2：

12 1.被證2、3、6及7之組合是否足以證明系爭專利2請求項1至
13 7、9至15不具進步性？

14 2.被證1、2、3、6及7之組合是否足以證明系爭專利2請求項8
15 不具進步性？

16 三、原告依專利法第96條第2項、公司法第23條第2項、民法第18
17 5條之規定，請求被告等對原告連帶負損害賠償責任，有無
18 理由？若有，則金額為何？

19 四、原告依專利法第96條第1項、第3項，請求被告超越群公司、
20 費西公司排除侵害並銷毀系爭產品，有無理由？

21 伍、系爭專利及系爭產品技術內容(被告等所提專利有效性之證
22 據技術內容部分不另於本判決逐一分析，理由詳後述)：

23 一、系爭專利1技術分析：

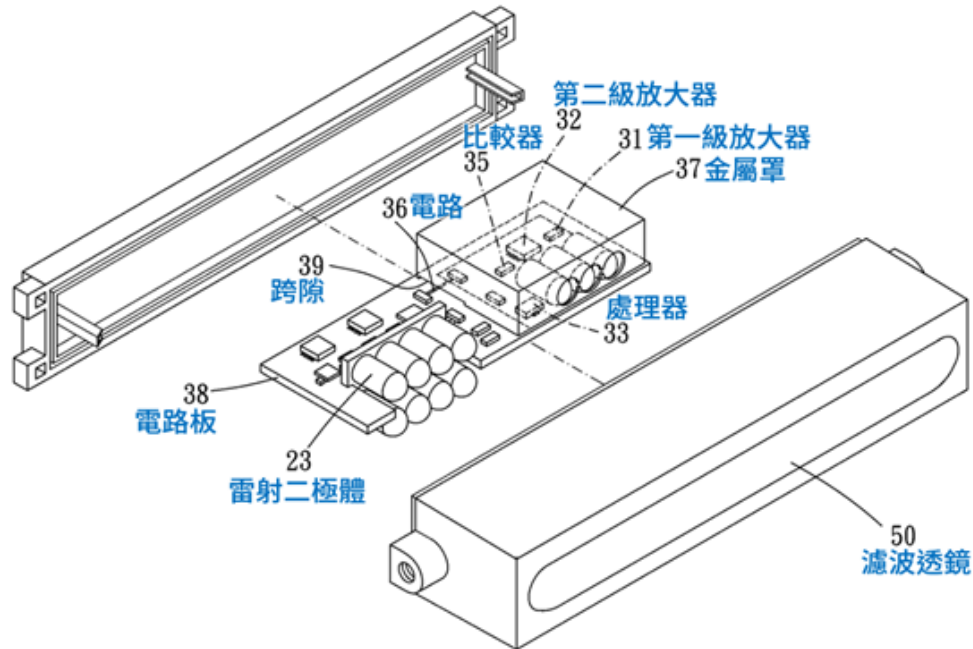
24 (一)系爭專利1之技術內容：

25 系爭專利1係關於一種雷射干擾器，包括：一光接收器，供
26 接收一包括複數入射脈波之入射雷射光並產生一與該複數入
27 射脈波相關聯之入射光訊號；一光發射器；一處理單元，依
28 據該入射光訊號計算該複數入射脈波之相鄰(二)者之間的間隔
29 時間、且驅動該光發射器產生一干擾雷射光，該干擾雷射光
30 包括複數干擾脈波，該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射

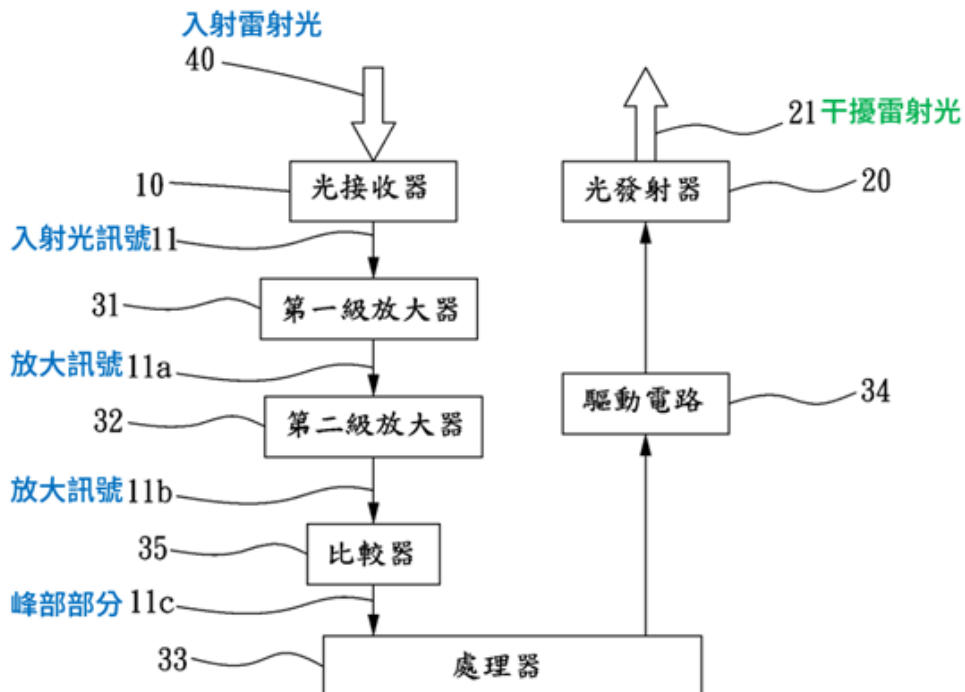
脈波之間隔時間內發射、且各持續至重疊於其中一該入射脈波（見系爭專利1摘要，本院卷一第37頁）。

(二)系爭專利1之主要圖式：

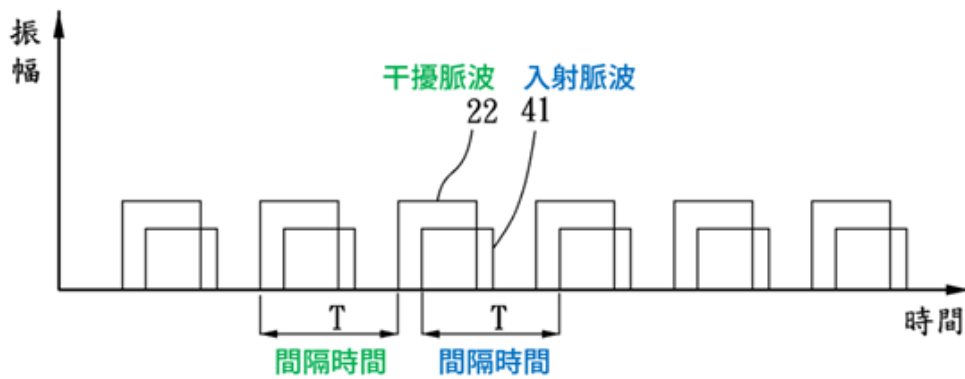
1.系爭專利1圖2為雷射干擾器之分解圖



2.系爭專利1圖4為雷射干擾器之結構方塊圖



3.系爭專利1圖6為訊號干擾示意圖



(三)系爭專利1申請專利範圍：

系爭專利1核准公告之請求項共13項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項。被告對系爭專利1提起舉發，原告則提出申請專利範圍更正本（110年7月9日更正本），經智慧財產局於112年4月14日審定「110年7月9日之更正事項，准予更正。請求項1至13舉發不成立」。系爭專利1更正後請求項1至13內容如下：

1.請求項1：

一種雷射干擾器，包括：

一光接收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷射光並產生一與該複數入射脈波相關聯之入射光訊號；

一光發射器；

一處理單元，依據該入射光訊號計算該複數入射脈波之相鄰二者之間的間隔時間、且驅動該光發射器產生一干擾雷射光，該干擾雷射光包括複數干擾脈波，該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射、且各持續至重疊於其中一該入射脈波。

2.請求項2：

如請求項1所述的雷射干擾器，其中該干擾脈波之振幅大於該入射脈波之振幅，該光接收器連接於一電路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光接收器。

3.請求項3：

如請求項1所述的雷射干擾器，其中各該干擾脈波持續至重疊於其中一該入射脈波之1/2以上，該光接收器連接於一電

01 路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光接
02 收器。

03 4.請求項4：

04 如請求項1所述的雷射干擾器，其中該干擾雷射光之發射訊
05 號頻率與該入射雷射光之發射訊號頻率相同，該光接收器連
06 接於一電路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩具
07 有一跨隙，該跨隙跨過該電路板之一電路。

08 5.請求項5：

09 如請求項1所述的雷射干擾器，其中該複數入射脈波之數量
10 至少為3個，該光接收器及該光發射器連接於一電路板，該
11 電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光接收器；該
12 金屬罩具有一跨隙，該跨隙跨過該電路板之一電路，該濾波
13 透鏡設於一外殼，該光接收器及該光發射器設於該外殼中。

14 6.請求項6：

15 如請求項1所述的雷射干擾器，其中該處理單元包括一與該
16 光接收器通聯之第一級放大器、一與該第一級放大器通聯之
17 第二級放大器、一與該第二級放大器通聯之處理器，該處理
18 器與該光發射器通聯，該第一級及第二級放大器處理該入射
19 光訊號成一放大訊號，該處理器依據該放大訊號間隔時間、
20 且驅動該光發射器產生該干擾雷射光。

21 7.請求項7：

22 如請求項6所述的雷射干擾器，其中該第一級放大器為電晶
23 體放大器，該第二級放大器為視頻放大器，該處理單元另包
24 括一通聯於該視頻放大器與該處理器之間的比較器，該比較
25 器設有一閾值，該比較器僅允許經該視頻放大器處理後之放
26 大訊號大於該閾值的峰部部分通過，該等峰部部分中之相鄰
27 二者之間間隔該間隔時間。

28 8.請求項8：

29 如請求項7所述的雷射干擾器，其中該閾值設為該放大訊號
30 之電壓值、電流值或振幅值，該光接收器連接於一電路板，

該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光接收器，
該金屬罩具有一跨隙，該跨隙跨過該電路板之一電路。

9.請求項9：

如請求項1所述的雷射干擾器，其中於該光接收器之前方另
設有一濾波透鏡，該濾波透鏡僅允許700奈米至950奈米波長
的光通過，該濾波透鏡設於一外殼，該光接收器及該光發射
器設於該外殼中。

10.請求項10：

如請求項8所述的雷射干擾器，其中該光接收器包括至少一
光電二極體，該光發射器包括至少一雷射二極體；該光電二
極體具有一介於40度至80度之光接收角，該雷射二極體具有
一介於15度至45度之光發射角；該干擾雷射光與該入射雷射
光之發射訊號頻率相同，該干擾雷射光與該入射雷射光之波
長介於850奈米至910奈米之間，該發射訊號頻率介於100赫
茲至600赫茲之間；該干擾脈波之振幅大於該入射脈波之振
幅；各該干擾脈波持續至重疊於其中一該入射脈波之3/4以
上；該複數入射脈波之數量至少為3個，該干擾雷射光相對
地於其前三個入射脈波之後發射；於該光接收器之前方另設
有一濾波透鏡，該濾波透鏡為塑材且僅允許700奈米至900奈
米波長的光通過，該光接收器及該光發射器連接於一電路
板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光接收
器；該金屬罩具有一跨隙，該跨隙跨過該電路板之一電路，
該濾波透鏡設於一外殼，該光接收器及該光發射器設於該外
殼中。

11.請求項11：

如請求項2所述的雷射干擾器，其中該處理單元包括一與該
光接收器通聯之第一級放大器、一與該第一級放大器通聯之
第二級放大器、一與該第二級放大器通聯之處理器，該處理
器與該光發射器通聯，該第一級及第二級放大器處理該入射
光訊號成一放大訊號，該處理器依據該放大訊號間隔時間、
且驅動該光發射器產生該干擾雷射光。

12.請求項12：

如請求項3所述的雷射干擾器，其中該處理單元包括一與該光接收器通聯之第一級放大器、一與該第一級放大器通聯之第二級放大器、一與該第二級放大器通聯之處理器，該處理器與該光發射器通聯，該第一級及第二級放大器處理該入射光訊號成一放大訊號，該處理器依據該放大訊號間隔時間、且驅動該光發射器產生該干擾雷射光。

13.請求項13：

如請求項4所述的雷射干擾器，其中該處理單元包括一與該光接收器通聯之第一級放大器、一與該第一級放大器通聯之第二級放大器、一與該第二級放大器通聯之處理器，該處理器與該光發射器通聯，該第一級及第二級放大器處理該入射光訊號成一放大訊號，該處理器依據該放大訊號間隔時間、且驅動該光發射器產生該干擾雷射光。

二、系爭專利2之技術分析：

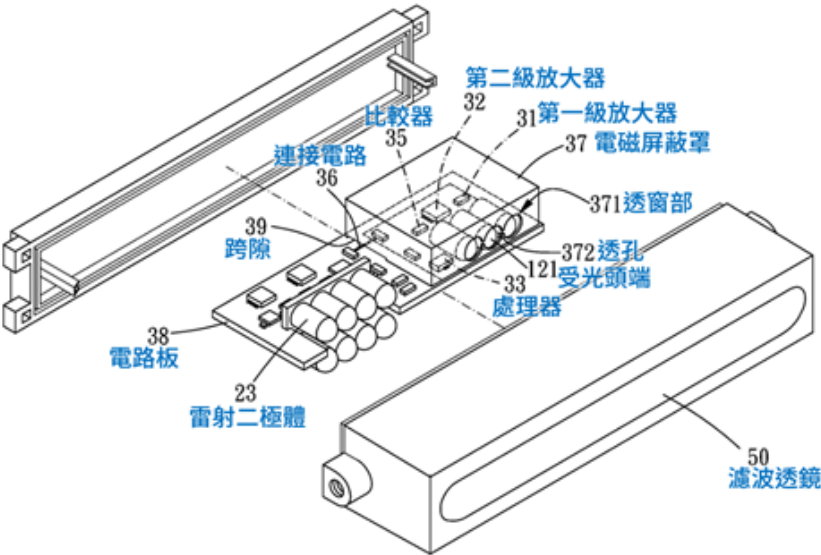
(一)系爭專利2之技術內容：

系爭專利2係關於一種雷射干擾器，包括：一光接收器，供接收一入射雷射光並產生一入射光訊號；一光發射器；一處理單元，與該光接收器及該光發射器電性連接，包括一訊號放大單元，該訊號放大單元電性連接該光接收器並處理該入射光訊號成一放大訊號，該處理單元依據該放大訊號驅動該光發射器產生一干擾雷射光；一電磁屏蔽罩，至少罩蓋屏蔽該訊號放大單元。（見系爭專利2摘要，本院卷一第57頁）

(二)系爭專利2主要圖式：

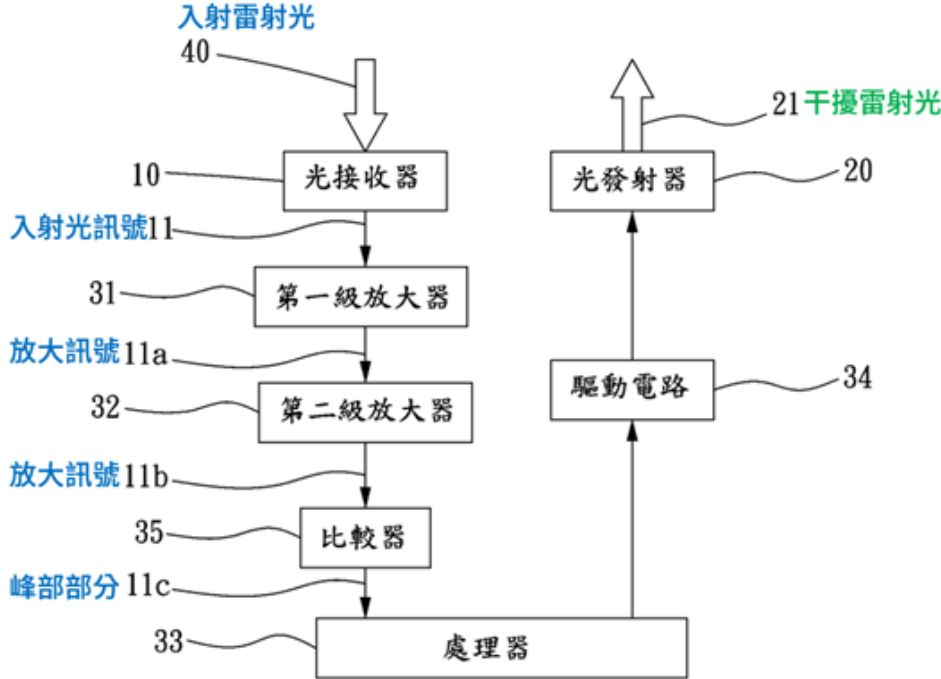
1.系爭專利2圖2為雷射干擾器之分解圖

01



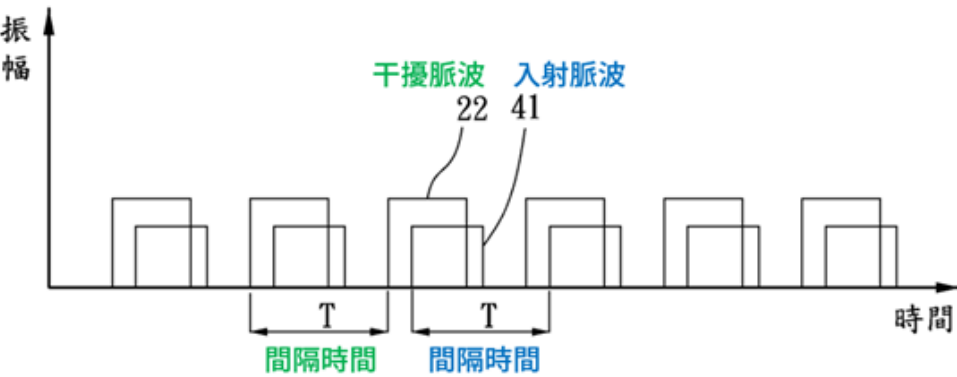
02
03
04

2.系爭專利2圖4為雷射干擾器之結構方塊圖



05
06

3.系爭專利2圖6為訊號干擾示意圖



07

08

(三)系爭專利2申請專利範圍：

系爭專利2核准公告之請求項共9項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項。原告於舉發案中提出系爭專利2申請專利範圍更正本（112年6月30日更正本），更正後請求項共16項，因原告主張系爭專利2請求項1至15受侵害，故僅列出請求項1至15內容如下：

1.請求項1：

一種雷射干擾器，包括：

一光接收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷射光並產生一入射光訊號；

一光發射器；

一處理單元，與該光接收器及該光發射器電性連接，包括一訊號放大單元，該訊號放大單元電性連接該光接收器並處理該入射光訊號成一放大訊號，該處理單元依據該放大訊號驅動該光發射器產生一包括複數干擾脈波之干擾雷射光，該干擾雷射光之干擾脈波係與該入射雷射光之入射脈波至少部份重疊；

一電磁屏蔽罩，至少罩蓋屏蔽該訊號放大單元；

其中該電磁屏蔽罩另設有至少一對應於該光接收器之透光部；

其中該光接收器連接於一電路板，該電磁屏蔽罩固定於該電路板之一側上。

2.請求項2：

如請求項1所述的雷射干擾器，其中該電磁屏蔽罩係為金屬罩，該金屬罩遮罩該光接收器。

3.請求項3：

如請求項1所述的雷射干擾器，其中該光接收器包括複數光電二極體，各該光電二極體包括一受光頭端，該透窗部包括對應於該複數光電二極體之受光頭端的複數透孔，該金屬罩具有一跨隙，該跨隙跨過該電路板之一電路。

4.請求項4：

01 如請求項3所述的雷射干擾器，其中該複數透孔與該複數光
02 電二極體之受光頭端形狀概為對應，且該複數透孔橫向連
03 通，於該光接收器之前方另設有一濾波透鏡，該濾波透鏡設
04 於一外殼，該光接收器及該光發射器設於該外殼中。

05 5.請求項5：

06 如請求項1所述的雷射干擾器，其中該光接收器接收該入射
07 雷射光並產生一與該複數入射脈波相關聯之入射光訊號，該
08 處理單元依據該入射光訊號計算該複數入射脈波之相鄰二者
09 之間的間隔時間，該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈
10 波之相鄰二者之間的間隔時間內發射。

11 6.請求項6：

12 如請求項5所述的雷射干擾器，其中該複數干擾脈波各持續
13 至重疊於其中一該入射脈波。

14 7.請求項7：

15 如請求項4所述的雷射干擾器，其中該電磁屏蔽罩係為金屬
16 罩；該光接收器接收該入射雷射光並產生一與該複數入射脈
17 波相關聯之入射光訊號，該處理單元依據該入射光訊號計算
18 該複數入射脈波之相鄰二者之間的間隔時間，該複數干擾脈
19 波間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射；該處理單
20 元包括一與該光接收器通聯之第一級放大器、一與該第一級
21 放大器通聯之第二級放大器、一與該第二級放大器通聯之處
22 理器，該處理器與該光發射器通聯，該第一級及第二級放大
23 器處理該入射光訊號成該放大訊號，該處理器依據該放大訊
24 號間隔時間、且驅動該光發射器產生該干擾雷射光；該複數
25 干擾脈波各持續至重疊於其中一該入射脈波之 $1/2$ 以上；該
26 干擾雷射光之發射訊號頻率與該入射雷射光之發射訊號頻率
27 相同；該複數入射脈波之數量至少為3個；該干擾脈波之振
28 幅大於該入射脈波之振幅；該光接收器及該光發射器固定於
29 該電路板上。

30 8.請求項8：

01 如請求項7所述的雷射干擾器，其中該第一級放大器為電晶
02 體放大器，該第二級放大器為視頻放大器，該處理單元另包
03 括一通聯於該視頻放大器與該處理器之間的比較器，該比較
04 器設有一閾值，該比較器僅允許經該視頻放大器處理後之放
05 大訊號大於該閾值的峰部部分通過，該等峰部部分中之相鄰
06 二者之間間隔該間隔時間。

07 9.請求項9：

08 如請求項1所述的雷射干擾器，其中該雷射干擾器另包括一
09 電性連接於該光發射器之驅動電路、及一電性連接於該光發
10 射器與該驅動電路之間的連接電路，該電磁屏蔽罩空跨過該
11 連接電路。

12 10.請求項10：

13 如請求項2所述的雷射干擾器，其中該雷射干擾器另包括一
14 電性連接於該光發射器之驅動電路、及一電性連接於該光發
15 射器與該驅動電路之間的連接電路，該電磁屏蔽罩空跨過該
16 連接電路。

17 11.請求項11：

18 如請求項3所述的雷射干擾器，其中該雷射干擾器另包括一
19 電性連接於該光發射器之驅動電路、及一電性連接於該光發
20 射器與該驅動電路之間的連接電路，該電磁屏蔽罩空跨過該
21 連接電路。

22 12.請求項12：

23 如請求項4所述的雷射干擾器，其中該雷射干擾器另包括一
24 電性連接於該光發射器之驅動電路、及一電性連接於該光發
25 射器與該驅動電路之間的連接電路，該電磁屏蔽罩空跨過該
26 連接電路。

27 13.請求項13：

28 如請求項5所述的雷射干擾器，其中該雷射干擾器另包括一
29 電性連接於該光發射器之驅動電路、及一電性連接於該光發
30 射器與該驅動電路之間的連接電路，該電磁屏蔽罩空跨過該
31 連接電路。

14.請求項14：

如請求項6所述的雷射干擾器，其中該雷射干擾器另包括一電性連接於該光發射器之驅動電路、及一電性連接於該光發射器與該驅動電路之間的連接電路，該電磁屏蔽罩空跨過該連接電路。

15.請求項15：

如請求項7所述的雷射干擾器，其中該雷射干擾器另包括一電性連接於該光發射器之驅動電路、及一電性連接於該光發射器與該驅動電路之間的連接電路，該電磁屏蔽罩空跨過該連接電路。

三、系爭產品技術內容：

原告主張系爭產品1、2、3對於系爭專利1、2均構成文義及均等侵權。

(一)系爭產品1：



系爭產品1之外盒包裝如上左圖（本院卷一第75頁），系爭產品1之本體及其連接線等如上右圖所示（本院卷一第77頁）。

(二)系爭產品2：



系爭產品2之外盒包裝如上左圖（本院卷一第151頁），系爭產品2之本體及其連接線等如上右圖所示（本院卷一第155頁）。

(三)系爭產品3：



系爭產品3之外盒包裝如上左圖（本院卷三第39頁），系爭產品3之本體及其連接線等如上右圖所示（本院卷三第39頁）。

陸、得心證之理由：

一、系爭產品1：

(一)系爭產品1未落入系爭專利1請求項1至7、11至13之文義範圍，亦未落入系爭專利1請求項8、10之均等範圍：

1.系爭專利1請求項1之技術特徵解析：

(1)原告於110年7月9日向智慧財產局申請更正系爭專利1（本院卷二第81至107頁），經智慧財產局併同舉發案審查於112年4月14日審定「110年7月9日之更正事項，准予更正」、「請求項1至13舉發不成立」（本院卷五第29至66頁）。前述更正內容業經智慧財產局於112年5月11日公告在案，依專利法第68條第3項規定，說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效，是就系爭專利1之侵權比對，應以110年7月9日更正內容為準。

(2)系爭專利1請求項1可解析為下列1A至1E技術特徵：

①1A：「一種雷射干擾器，包括：」。

②1B：「一光接收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷射光並產生一與該複數入射脈波相關聯之入射光訊號；」。

01 ③1C：「一光發射器；」。

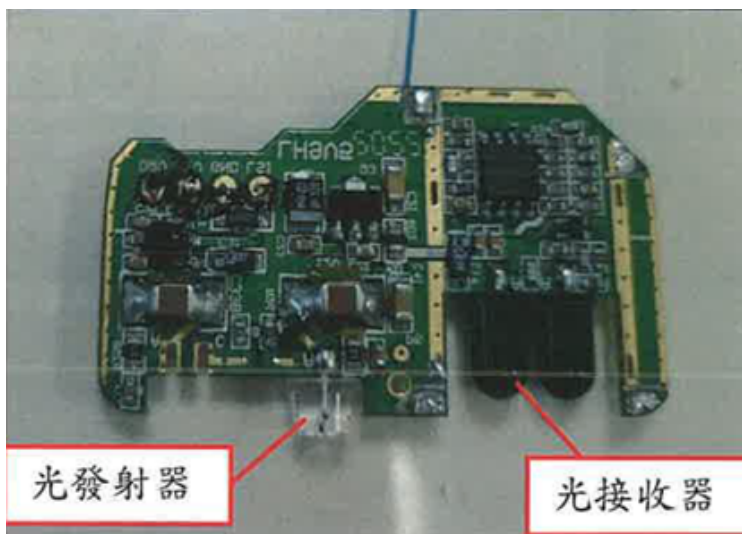
02 ④1D：「一處理單元，依據該入射光訊號計算該複數入射
03 脈波之相鄰二者之間的間隔時間、且驅動該光發射器產
04 生一干擾雷射光，」。

05 ⑤1E：「該干擾雷射光包括複數干擾脈波，該複數干擾脈
06 波間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射、且各
07 持續至重疊於其中一該入射脈波。」

08 2.系爭產品1未落入系爭專利1請求項1之文義範圍：

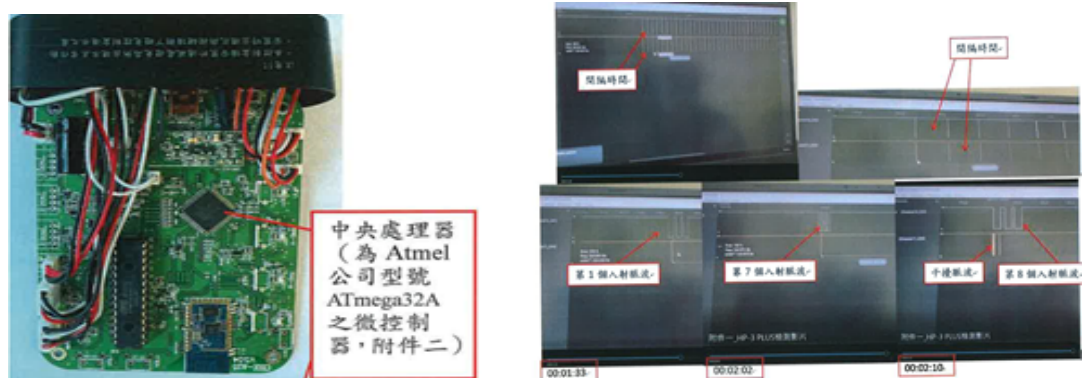
09 (1)1A技術特徵：依系爭產品1之外包裝盒所示（本院卷一第7
10 5頁），系爭產品1係南極星HP-3 Plus「雷射二極體無線
11 防護罩」，並註明其功能為「防禦三眼雷射槍」、「對於
12 現役雷射測速儀可達到JTG反制最高標準」等，亦即系爭
13 產品1係用來干擾雷射測速儀(槍)之偵測，即為1A技術特
14 徵之「一種雷射干擾器」。

15 (2)1B及1C技術特徵：系爭產品1經拆解後，其內部電路板上
16 設有光接收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷射光
17 （參下述1D技術特徵）並產生一與該複數入射脈波相關聯
18 之入射光訊號，該電路板上另設有一光發射器（如下圖所
19 示，本院卷三第66頁），可發射干擾雷射光（參下述1D技
20 術特徵），對應於1B及1C技術特徵。



22 (3)1D技術特徵：系爭產品1另一電路板上設有微控制器（型
23 號：ATmega32A，如下左圖，本院卷三第69頁），其規格

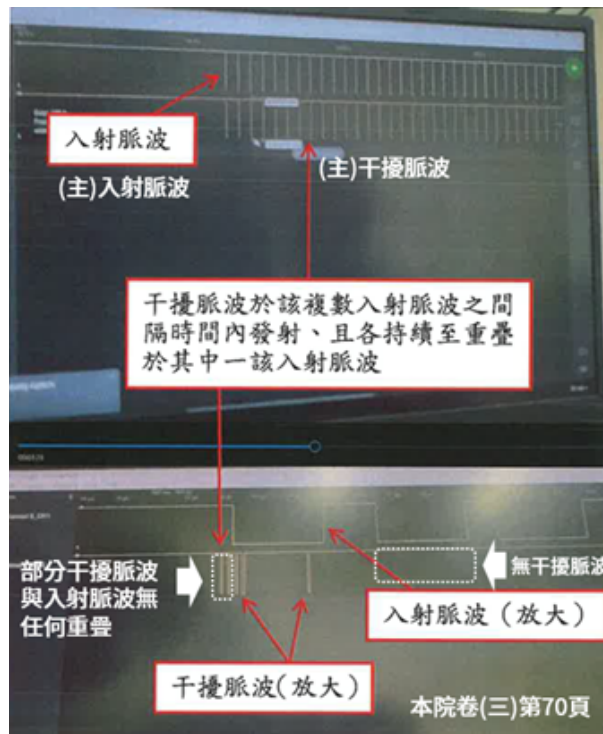
書如甲證20附件2（本院卷三第97至119頁）所示；另依系爭產品1之檢測結果，系爭產品1在前7個入射光訊號（本院卷三第9頁）並無干擾雷射光（干擾脈波）產生，而在第8個入射光訊號（入射脈波）前，系爭產品1產生干擾脈波，且干擾脈波之間隔時間對應於入射脈波之間隔時間（如下右圖，本院卷三第11至12頁），據此可知系爭產品1之微控制器（相當於1D技術特徵之「處理單元」）依據入射光訊號計算複數入射脈波之相鄰間隔時間，驅動光發射器產生干擾雷射光，是以系爭產品1具有1D技術特徵。



(4)1E技術特徵：

①如甲證20第23頁（如下圖，本院卷三第70頁）所示，系爭產品1經原告檢測，其發出之干擾雷射光包括複數干擾脈波，且間斷地於複數入射脈波之間隔時間內發射，固然對應於1E技術特徵之「該干擾雷射光包括複數干擾脈波，該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射…」部分。

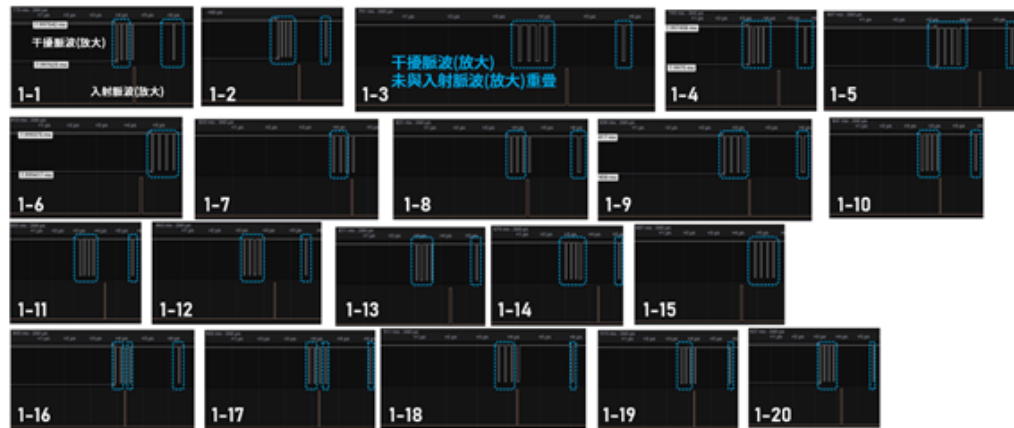
②惟就1E技術特徵中「複數干擾脈波…各持續至重疊於其中一該入射脈波」部分，經檢視原告放大後之檢測結果波形圖（如下圖，本院卷三第70頁），各(主)入射脈波包含複數入射脈波(放大)，各(主)干擾脈波亦包含複數干擾脈波(放大)，顯然有部分的干擾脈波(放大)完全未與任何入射脈波重疊，或第二個入射脈波(放大)以後並無任何干擾脈波(放大)與之相互重疊，與前述技術特徵並不相符。



③原告主張系爭產品1具有技術特徵1E，無非是認為系爭產品1只要有任何干擾脈波與入射脈波重疊即可，惟前述1E技術特徵明確界定「複數干擾脈波…『各』持續至重疊於其中一該入射脈波」，亦即各個干擾脈波均需與入射脈波相重疊。復參酌系爭專利1說明書第【0011】段所載「該干擾雷射光21之發射訊號頻率與該入射雷射光40之發射訊號頻率相同，確保同步干擾該雷射偵測器接收反射之入射雷射光。…。各該干擾脈波22持續至重疊於其中一該入射脈波41之1/2以上，較佳為重疊3/4以上、甚至完全重疊，以完全阻斷、干擾該雷射偵測器接收反射之入射雷射光」、「較佳地，該複數入射脈波41之數量至少為3個，該干擾雷射光21相對地於其前三個入射脈波41之後發射，以確定所接收之入射脈波41所具有之光波長、訊號發射頻率、振幅等性質，確實為所欲干擾之目標入射雷射，避免誤判及該光發射器20不必要地發射該干擾雷射光21，精準而節能」，可知系爭專利1係以相同於入射脈波頻率之干擾脈波，來阻斷、干擾雷射偵測器接收反射之入射脈波，益見前述1E技術特徵之「複數干擾脈波…各持續至重疊於其中一該入射脈

波」，係指各干擾脈波與各入射脈波至少部分重疊，否則無法達成系爭專利1精準干擾雷射偵測器之發明目的。又原告對於系爭專利1請求項1前述技術特徵之解釋亦係「out of phase」（脈波部分重疊）（參原告113年7月18日庭呈「專利有效性部分」簡報第4、5頁），即兩脈波間雖有相位差但均部分重疊，而非僅有少部分的脈波重疊，其餘脈15波卻完全不重疊之情形。觀之兩造會同鑑驗系爭產品所做出如下圖之波形圖（本院卷六第183頁），原告所提關於系爭產品1的20個波形圖中，其中編號1-1、1-7、1-8、1-16至1-19之波形圖顯示複數干擾脈波中僅有1個干擾脈波有與入射脈波重疊，此與技術特徵1E之「複數干擾脈波…各持續至重疊於其中一該入射脈波」不符；而其餘13個波形圖中之干擾脈波與入射脈波並無任何重疊，亦與技術特徵1E之「複數干擾脈波…各持續至重疊於其中一該入射脈波」不符，故系爭產品1未具備部分1E之技術特徵。

系爭產品1 (HP-3 Plus) 檢測波形圖 (本院卷(六)第183頁)



④綜上，系爭產品1雖具有系爭專利1請求項1之1A至1D技術特徵，然欠缺部分的1E技術特徵即「複數干擾脈波…各持續至重疊於其中一該入射脈波」。是以，系爭專利1請求項1未文義讀取系爭產品1，系爭產品1並未構成文義侵權。

3.系爭產品1未落入系爭專利1請求項2至7、11至13之文義範圍：

系爭專利1請求項2至7、11至13係請求項1之直接或間接附屬項，均包含請求項1之全部技術特徵。系爭產品1未構成系爭專利1請求項1之文義侵權，業如前述。則系爭產品1亦未構成系爭專利1請求項2至7、11至13之文義侵權。

4.系爭產品1未落入系爭專利1請求項8、10之均等範圍：

系爭專利1請求項8依附於請求項7，系爭專利1請求項10則依附於請求項8，均具有請求項1之全部技術特徵。就系爭專利1請求項8關於「該閾值設為該放大訊號之電壓值、電流值或振幅值」之附屬技術特徵、請求項10關於「該光電二極體具有一介於40度至80度之光接收角，該雷射二極體具有一介於15度至45度之光發射角」之附屬技術特徵，原告均未主張系爭產品1對應之技術特徵為何，而逕以系爭產品1與系爭專利1就方式、功能及結果實質相同而主張構成均等侵權（本院卷三第77、79、89、90頁），難認已舉證證明。又系爭專利1請求項8、10具有請求項1之全部技術特徵，而系爭產品1僅有極少數之干擾脈波與入射脈波重疊，亦如前述，與請求項1關於「複數干擾脈波…各持續至重疊於其中一該入射脈波」技術特徵具有實質差異，故二者之方式、功能及結果均非實質相同，未構成均等侵權。

(二)系爭產品1未落入系爭專利2請求項1至3、5至6、9至11、13至14文義範圍，亦未落入系爭專利2請求項4、7、8、12、15均等範圍：

1.系爭專利2請求項1之技術特徵解析：

(1)原告於110年8月30日向智慧財產局（下稱智慧局）申請更正系爭專利2（本院卷二第110至133頁），嗣經智慧局併同舉發案審查，原告復於112年6月30日重提更正本，經智慧局於112年11月29日審定「112年6月30日之更正事項，准予更正」、「請求項1至15舉發不成立」（本院卷五第479至481頁）。嗣智慧局雖自行撤銷前述審定並重新審查，惟其自行撤銷理由與更正部分無關（本院卷六第75、

76頁），且兩造均同意以112年6月30日更正內容為系爭專利2侵權比對之基礎，合先敘明。

(2)系爭專利2請求項1可解析為下列1a至1g技術特徵：

①1a：「一種雷射干擾器，包括：」

②1b：「一光接收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷射光並產生一入射光訊號；」

③1c：「一光發射器；」

④1d：「一處理單元，與該光接收器及該光發射器電性連接，包括一訊號放大單元，該訊號放大單元電性連接該光接收器並處理該入射光訊號成一放大訊號，該處理單元依據該放大訊號驅動該光發射器產生一包括複數干擾脈波之干擾雷射光」

⑤1e：「該干擾雷射光之干擾脈波係與該入射雷射光之入射脈波至少部份重疊；」

⑥1f：「一電磁屏蔽罩，至少罩蓋屏蔽該訊號放大單元；其中該電磁屏蔽罩另設有至少一對應於該光接收器之透光部；」

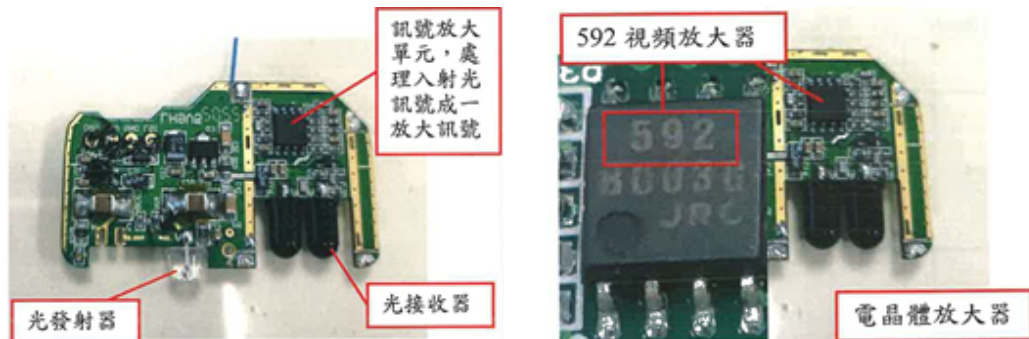
⑦1g：「其中該光接收器連接於一電路板，該電磁屏蔽罩固定於該電路板之一側上。

2.系爭產品1未落入系爭專利2請求項1之文義範圍：

(1)1a至1c技術特徵：系爭專利2請求項1之1a至1c技術特徵，略同於系爭專利1請求項1之1A至1C技術特徵，而系爭產品1具有系爭專利1請求項1之1A至1C技術特徵，業如前述，故系爭產品1亦具有系爭專利2請求項1之1a至1c技術特徵。

(2)1d技術特徵：系爭產品1於電路板上設有微控制器（型號：ATmega32A，見本院卷三第174頁），與光接收器及光發射器電性連接；系爭產品1另設有如下圖所示之視訊放大器（型號：592，見本院卷三第175、188頁），其規格書如甲證21附件4所示（本院卷三第253至262頁）；依系爭產品1之檢測結果（本院卷三第175頁）可知，系爭

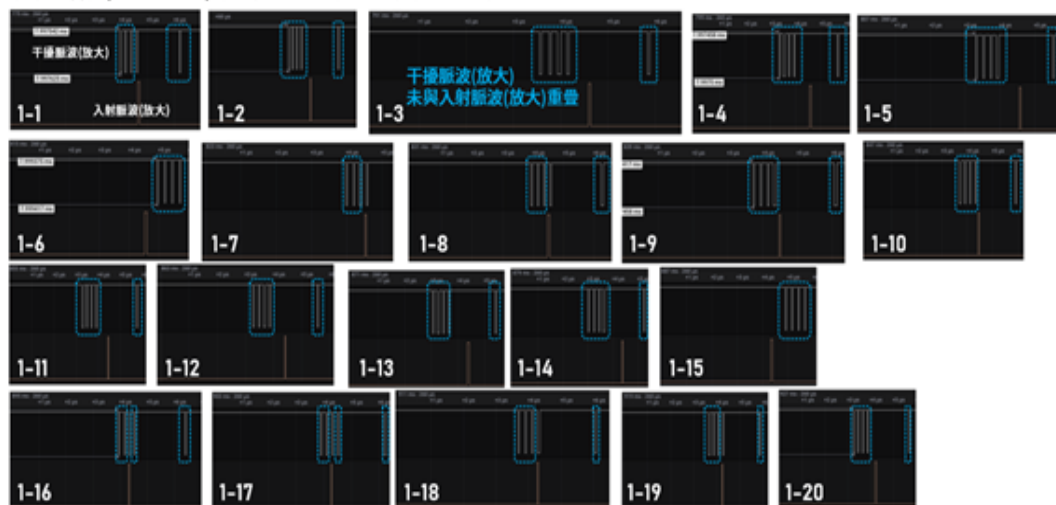
產品1因應入射光訊號，會產生包括複數干擾脈波之干擾雷射光，是系爭產品1之微控制器會依據放大器經由光接收器所接收到的入射光訊號，驅動光發射器產生干擾雷射光，故具有1d技術特徵。



(3)1e技術特徵：

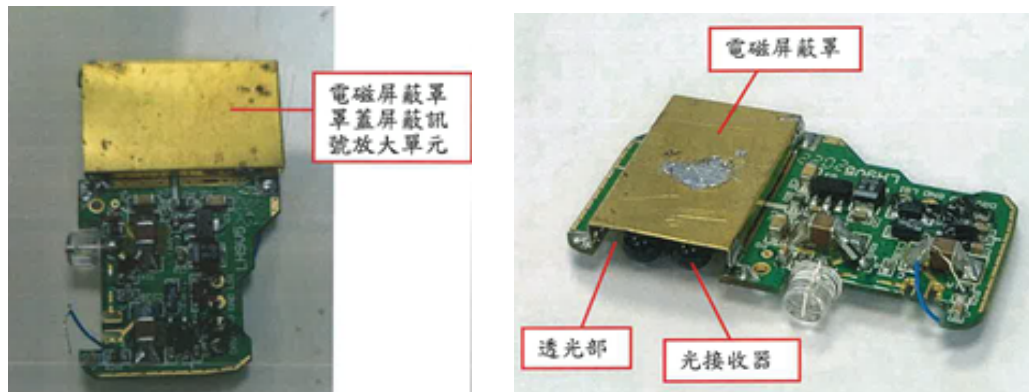
原告對於系爭專利2請求項1前述技術特徵之解釋亦係「out of phase」（脈波部分重疊）（參原告113年7月18日庭呈「專利有效性部分」簡報第21、22頁），即兩脈波間雖有相位差但均部分重疊，而非僅有少部分的脈波重疊，其餘脈波卻完全不重疊之情形。觀之兩造會同鑑驗系爭產品1所得如下圖所示之波形圖（本院卷六第183頁），可知大部分之干擾脈波(放大)與入射脈波(放大)並無任何重疊，僅有極少部分之干擾脈波與入射脈波有部分重疊，應認系爭產品1並未包含1e技術特徵。

系爭產品1 (HP-3 Plus) 檢測波形圖 (本院卷(六)第183頁)

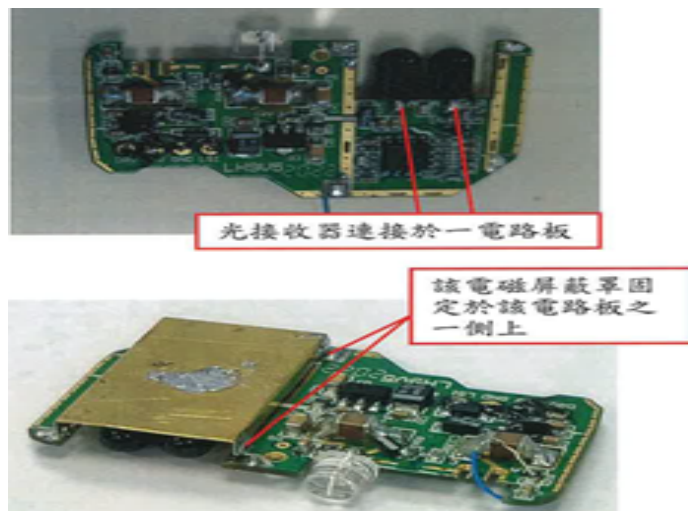


(4)1f技術特徵：依下圖所示（本院卷三第176、177頁），系爭產品1之視訊放大器上方設有一電磁屏蔽罩，且該電磁

01 屏蔽罩側邊可露出光接收器，即相當於1f技術特徵之透光
02 部，是以系爭產品1包含1f技術特徵。
03



04 (5)1g技術特徵：觀之下圖（本院卷三第177頁），系爭產品1
05 之光接收器連接於電路板上，且電磁屏蔽罩固定於該電路
06 板之一側上，故系爭產品1包含1g技術特徵。
07



08
09 (6)綜上，系爭產品1雖具有系爭專利2請求項1之1a至1d、1f
10 及1g技術特徵，惟欠缺1e關於「該干擾雷射光之干擾脈波
11 係與該入射雷射光之入射脈波至少部份重疊」之技術特
12 徵。是系爭專利2請求項1未文義讀取系爭產品1，系爭產
13 品1未構成文義侵權。

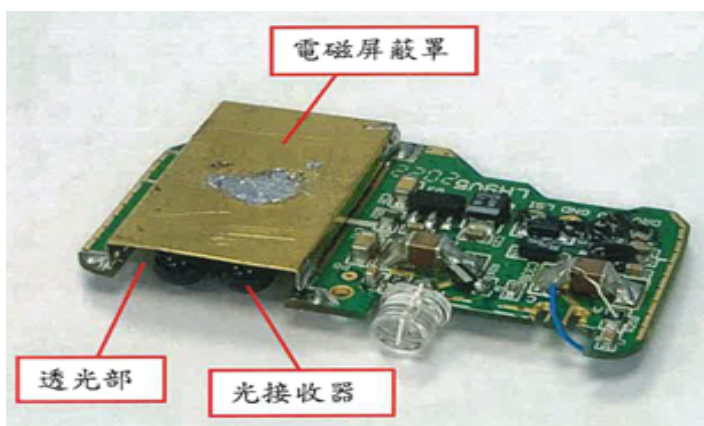
14 3.系爭產品1未落入系爭專利2請求項2、3、5、6、9至11、1
15 3、14之文義範圍：

16 系爭專利2請求項2、3、5、6、9至11、13、14係請求項1之
17 直接或間接附屬項，均包含請求項1之全部技術特徵。如前
18 述，系爭產品1未落入系爭專利2請求項1之文義範圍，則系

爭產品1自未構成系爭專利2請求項2、3、5、6、9至11、13、14之文義侵權。

4.系爭產品1未落入系爭專利2請求項4、7、8、12、15之均等範圍：

系爭專利2請求項4係請求項1之間接附屬項，具有請求項1之全部技術特徵。系爭專利請求項7、12依附於請求項4、請求項8、15依附於請求項7。原告主張請求項7、8、12、15之附屬技術特徵均已出現於系爭產品1，因前述請求項係直接或間接依附於請求項4，而請求項4關於「該複數透孔與該複數光電二極體之受光頭端形狀概為對應」之附屬技術特徵，雖未見於系爭產品1，但系爭產品1之電磁屏蔽罩之透光部可視為是複數個相連的透孔，故對請求項4、7、8、12、15構成均等侵權云云（本院卷三第195、196頁）。惟觀之下圖系爭產品1之電磁屏蔽罩係呈「冂」字型，其側邊供光電二極體露出處，並無任何可與受光頭端形狀對應之結構存在，是原告未就方式、功能與結果具體說明構成均等侵權之理由。又系爭產品1大部分之干擾脈波與入射脈波均不重疊，與系爭專利2請求項1之1e關於「該干擾雷射光之干擾脈波係與該入射雷射光之入射脈波至少部份重疊」之技術特徵具有實質差異，故系爭產品1就包含前述技術特徵之請求項4、7、8、12、15均未構成均等侵權。



二、系爭產品2：

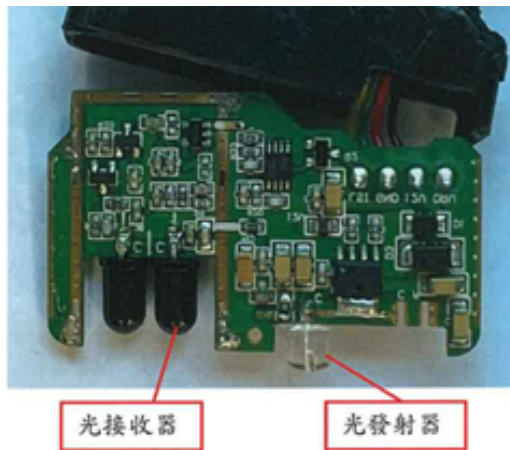
(一)系爭產品2未落入系爭專利1請求項1至7、11至13之文義範圍，亦未落入系爭專利1請求項8、10之均等範圍：

01 1.系爭產品2未落入系爭專利1請求項1之文義範圍：

02 (1)系爭專利1請求項1可解析為如前述1A至1E技術特徵。

03 (2)1A技術特徵：觀之系爭產品2外包裝盒（本院卷一第151、
04 153頁），系爭產品2係TMG α -15「雷射防護罩」，並註
05 明其功能可涵蓋多種雷射測速槍，相同於1A技術特徵之
06 「一種雷射干擾器」。

07 (3)1B及1C技術特徵：拆解系爭產品2可看到內部電路板上設
08 有光接收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷射光
09 （參下述1D技術特徵）並產生一與該複數入射脈波相關聯
10 之入射光訊號，該電路板上另設有如下圖所示之一光發射
11 器（參本院卷三第285頁），可發射干擾雷射光（參下述1
12 D技術特徵），相同於1B及1C技術特徵。
13

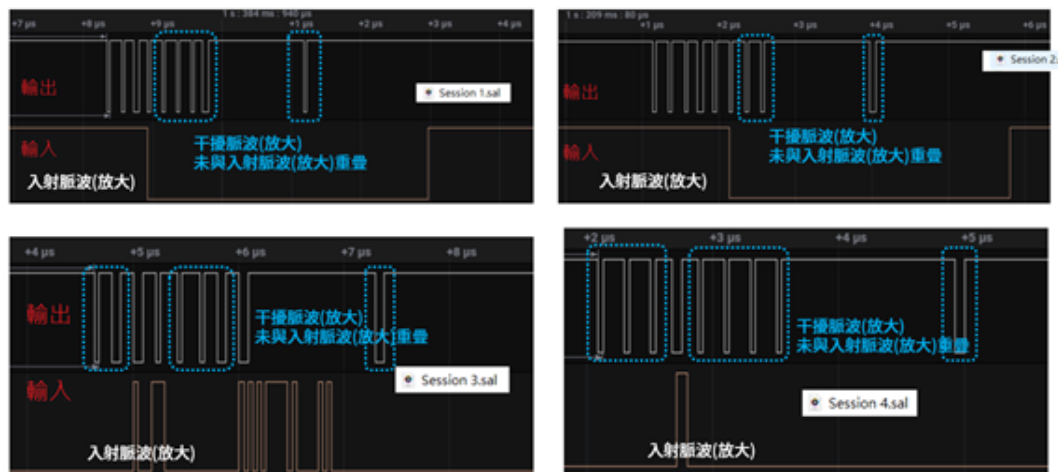


14 (4)1D技術特徵：系爭產品2另一電路板上設有如下左圖所示
15 之微控制器（型號：ATmega32A，見本院卷三第287、288
16 頁），有規格書可參（本院卷三第315至336頁）；又系爭
17 產品2因應入射光訊號產生干擾脈波，而干擾脈波之間隔
18 時間對應於入射脈波之間隔時間，有如下右圖之檢測波形
19 圖可考（本院卷三第286頁），可知系爭產品2之微控制器
20 （相當於1D技術特徵之「處理單元」）依據入射光訊號計
21 算複數入射脈波之相鄰間隔時間，驅動光發射器產生干擾
22 雷射光，故系爭產品2具有1D技術特徵。



(5) 1E技術特徵：觀諸兩造會同鑑驗系爭產品2所得出如下圖所示之波形圖（本院卷六第175頁），大部分之干擾脈波均未與入射脈波重疊，且干擾脈波與入射脈波之週期明顯不同，即各個干擾脈波並未與各個入射脈波相重疊，與1E之「複數干擾脈波…『各』持續至重疊於其中一該入射脈波」部分技術特徵不相符。

系爭產品2 (TMG α-15) 檢測波形圖 (本院卷(六)第175頁)



(6) 綜上，系爭產品2雖具有系爭專利1請求項1之1A至1D技術特徵，然欠缺1E關於「複數干擾脈波…各持續至重疊於其中一該入射脈波」之技術特徵。故系爭產品2對系爭專利1未構成文義侵權。

2. 系爭產品2未落入系爭專利1請求項2至7、11至13之文義範圍：

系爭專利1請求項2至7、11至13係請求項1之直接或間接附屬項，均包含請求項1之全部技術特徵。如前述，系爭產品2未構成系爭專利1請求項1之文義侵權，則系爭產品2未構成系爭專利1請求項2至7、11至13之文義侵權。

3. 系爭產品2未落入系爭專利1請求項8、10之均等範圍：

系爭專利1請求項8依附於請求項7，系爭專利1請求項10依附於請求項8，均具有請求項1之全部技術特徵。原告表示就系爭專利1請求項8、10之部分附屬技術特徵，無法確認系爭產品2對應之技術特徵為何，而係主張系爭產品2與系爭專利1就方式、功能及結果實質相同而構成均等侵權（見本院卷三第296至298、308至310頁），難認原告就此已舉證證明。又系爭專利1請求項8、10具有請求項1之全部技術特徵，而系爭產品2僅有少數之干擾脈波與入射脈波重疊，與請求項1關於「複數干擾脈波…各持續至重疊於其中一該入射脈波」之技術特徵，具有實質差異，二者之方式、功能及結果均難認實質相同，故未構成均等侵權。

(二)系爭產品2未落入系爭專利2請求項1至3、5至6、9至11、13至14文義範圍，亦未落入系爭專利2請求項4、7、8、12、15均等範圍：

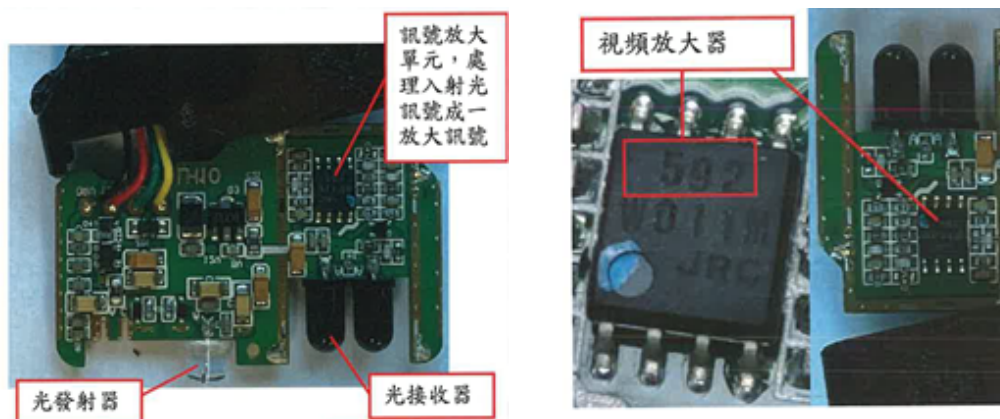
1.系爭產品2未落入系爭專利2請求項1之文義範圍：

(1)系爭專利2請求項1可解析為如前述1a至1g技術特徵。

(2)1a至1c技術特徵：系爭專利2請求項1之1a至1c技術特徵，略同於系爭專利1請求項1之1A至1C技術特徵，而系爭產品2具有系爭專利1請求項1之1A至1C技術特徵，業如前述，故系爭產品2亦具有系爭專利2請求項1之1a至1c技術特徵。

(3)1d技術特徵：系爭產品2於電路板上設有微控制器（型號：ATmega32A，見本院卷三第401、403頁），與光接收器及光發射器電性連接；系爭產品2另設有如下圖所示之視訊放大器（型號：592，見本院卷三第411、414頁），有規格書可佐（本院卷三第479至488頁）；依系爭產品2之檢測結果，系爭產品2因應入射光訊號，會產生包括複數干擾脈波之干擾雷射光（見本院卷三第402、403頁），可知系爭產品2之微控制器會依據放大器經由光接收器所接收到的入射光訊號，驅動光發射器產生干擾雷射光，具有1d技術特徵。

01



02

(4)1e技術特徵：依兩造會同鑑驗系爭產品2所得如下圖所示之波形圖（本院卷六第175頁），大部分之干擾脈波(放大)與入射脈波(放大)並無任何重疊，與1e關於「該干擾雷射光之干擾脈波係與該入射雷射光之入射脈波至少部份重疊」技術特徵不符，故系爭產品2未包含1e技術特徵。

03

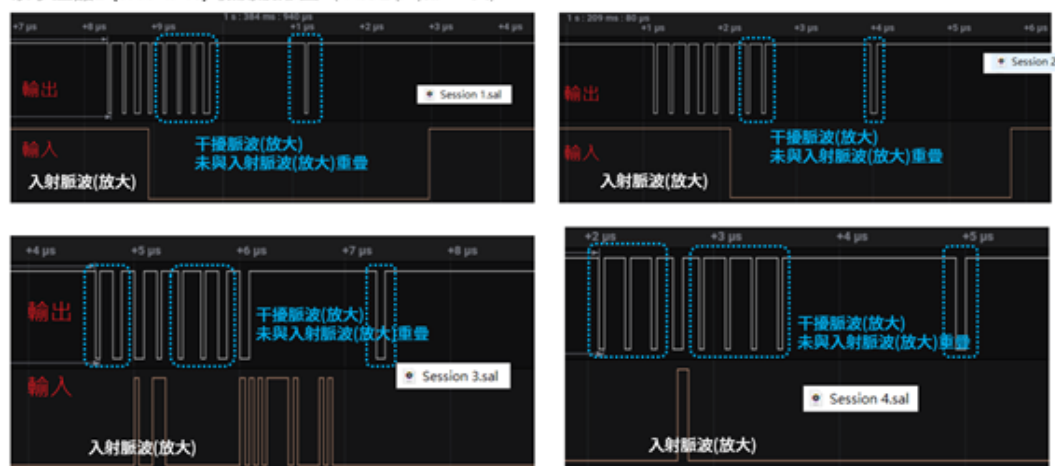
04

05

06

07 系爭產品2 (TMG α-15) 檢測波形圖 (本院卷(六)第175頁)

08



09

10

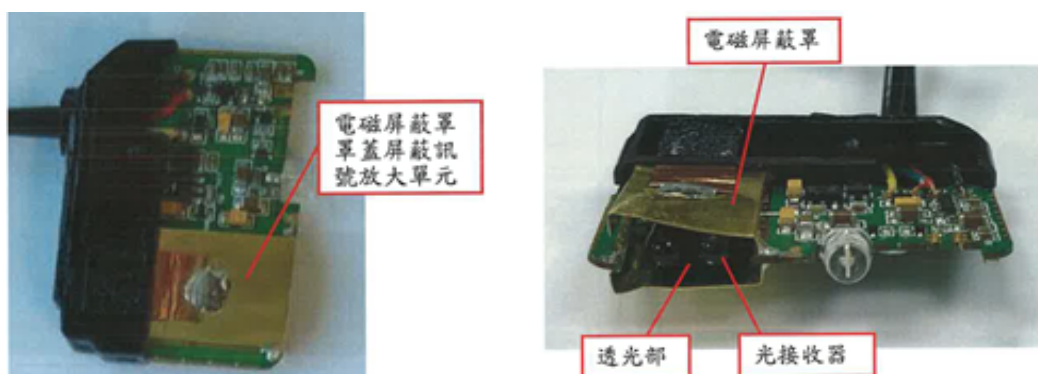
(5)1f技術特徵：觀諸系爭產品2如下圖所示之照片，可知其視訊放大器上方設有一電磁屏蔽罩，且該電磁屏蔽罩側邊可露出光接收器，即相當於1f技術特徵之透光部（參本院卷三第404頁），故系爭產品2包含1f技術特徵。

11

12

13

14



01 (6)1g技術特徵：系爭產品2之光接收器連接於電路板上，且
02 電磁屏蔽罩固定於該電路板之一側上（見本院卷三第40
03 4、405頁），故系爭產品2包含1g技術特徵。

04 (7)綜上，系爭產品2雖具有系爭專利2請求項1之1a至1d、1f
05 及1g之技術特徵，惟欠缺1e關於「該干擾雷射光之干擾脈
06 波係與該入射雷射光之入射脈波至少部份重疊」之技術特
07 徵。故系爭產品2對系爭專利2未構成文義侵權。

08 2.系爭產品2未落入系爭專利2請求項2、3、5、6、9至11、1
09 3、14之文義範圍：

10 系爭專利2請求項2、3、5、6、9至11、13、14係請求項1之
11 直接或間接附屬項，均包含請求項1之全部技術特徵。如前
12 述，系爭產品2未構成系爭專利2請求項1之文義侵權，則系
13 爭產品2自未構成系爭專利2請求項2、3、5、6、9至11、1
14 3、14之文義侵權。

15 3.系爭產品2未落入系爭專利2請求項4、7、8、12、15之均等
16 範圍：

17 系爭專利2請求項4係請求項1之間接附屬項，具有請求項1之
18 全部技術特徵。系爭專利請求項7、12係依附於請求項4、請
19 求項8、15則依附於請求項7。原告主張因請求項7、8、12、
20 15係直接或間接依附於請求項4，請求項4關於「該複數透孔
21 與該複數光電二極體之受光頭端形狀概為對應」之附屬技術
22 特徵，雖未見於系爭產品2，但系爭產品2之電磁屏蔽罩之透
23 光部可視為是複數個相連的透孔，故請求項7、8、12、15之
24 技術特徵均已出現於系爭產品2，故構成均等侵權云云（本
25 院卷三第422、423頁）。惟查，系爭產品2之電磁屏蔽罩係
26 呈「冂」字型，其側邊供光電二極體露出處，並無任何可與
27 受光頭端形狀對應之結構存在，足認原告未就方式、功能與
28 結果具體說明其構成均等侵權之理由。又系爭產品2大部分
29 之干擾脈波與入射脈波均不重疊，已如前述，與系爭專利2
30 請求項1之1e之「該干擾雷射光之干擾脈波係與該入射雷射

光之入射脈波至少部份重疊」技術特徵具有實質差異，故就請求項4、7、8、12、15未構成均等侵權。

三、系爭產品3：

(一)系爭產品3未落入系爭專利1請求項1至7、11至13之文義範圍，亦未落入系爭專利1請求項8、10之均等範圍：

1.系爭產品3未落入系爭專利1請求項1之文義範圍：

(1)系爭專利1請求項1可解析為如前述1A至1E技術特徵。

(2)1A技術特徵：系爭產品3係南極星HP-5 PLUS「雷射二極體防護罩」，採用次世代高階處理器、搭配寬廣域雙LD數位跳頻二極體，提供變頻與跳頻雙層防禦，完全防禦交通隊…雷射槍，有該產品之網頁銷售資訊及外包裝盒可參（本院卷三第23至39頁），相同於1A技術特徵之「一種雷射干擾器」。

(3)1B及1C技術特徵：系爭產品3經拆解後，其內部電路板上設有光接收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷射光（參下述1D技術特徵）並產生一與該複數入射脈波相關聯之入射光訊號，該電路板上另設有如下圖所示一光發射器（參本院卷三第285頁），可發射干擾雷射光（參下述1D技術特徵），相同於1B及1C技術特徵。



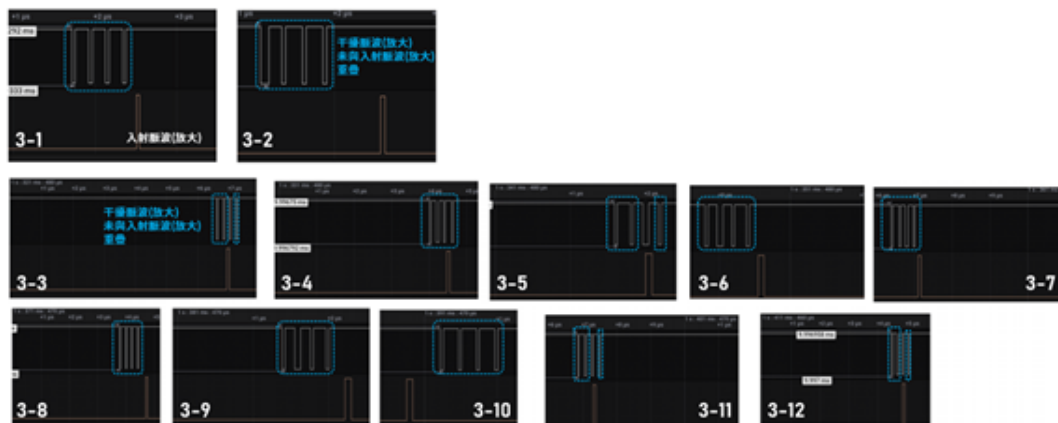
(4)1D技術特徵：系爭產品3另一電路板上設有如下左圖所示之微控制器（型號：ATmega32A，見本院卷三第514頁），有規格書可稽（本院卷三第541至563頁）；觀之系爭產品3如下右圖所示之檢測結果，系爭產品3因應入射光訊號產

生干擾脈波，且干擾脈波之間隔時間對應於入射脈波之間隔時間（見本院卷三第512頁），可知系爭產品3之微控制器（相當於1D技術特徵之「處理單元」）依據入射光訊號計算複數入射脈波之相鄰間隔時間，驅動光發射器產生干擾雷射光，是系爭產品3具有1D技術特徵。



(5) 1E技術特徵：觀諸兩造會同鑑驗系爭產品3所得如下圖所示之波形圖（本院卷六第179頁），編號3-1、3-2、3-6至3-10波形圖之干擾脈波與入射脈波完全沒有重疊，編號3-3至3-5、3-11、3-12波形圖顯示多個干擾脈波僅有1個干擾脈波與入射脈波相重疊，可知各個干擾脈波並未與各個入射脈波相重疊，與1E之「複數干擾脈波…『各』持續至重疊於其中一該入射脈波」部分技術特徵不符。

系爭產品3 (HP-5 Plus) 檢測波形圖 (本院卷(六)第179頁)



(6) 綜上，系爭產品3雖具有系爭專利1請求項1之1A至1D技術特徵，然欠缺1E關於「複數干擾脈波…各持續至重疊於其中一該入射脈波」之技術特徵。故系爭產品3對系爭專利1請求項1未構成文義侵權。

01 2.系爭產品3未落入系爭專利1請求項2至7、11至13之文義範
02 圍：

03 系爭專利1請求項2至7、11至13係請求項1之直接或間接附屬
04 項，均包含請求項1之全部技術特徵。系爭產品3未構成系爭
05 專利1請求項1之文義侵權，業如前述，則系爭產品3亦未構
06 成系爭專利1請求項2至7、11至13之文義侵權。

07 3.系爭產品3未落入系爭專利1請求項8、10之均等範圍：

08 系爭專利1請求項8依附於請求項7，系爭專利1請求項10依附
09 於請求項8，均具有請求項1之全部技術特徵。原告表示無法
10 確認系爭產品3對應的技術特徵為何，但主張系爭產品3與系
11 爭專利1請求項8、10就方式、功能及結果實質相同而構成均
12 等侵權（見本院卷三第531至536頁），難認已舉證證明。又
13 系爭專利1請求項8、10具有請求項1之全部技術特徵，而如
14 前述，系爭產品3僅有極少數之干擾脈波與入射脈波重疊，
15 與請求項1之「複數干擾脈波…各持續至重疊於其中一該入
16 射脈波」技術特徵，具有實質差異，方式、功能及結果難謂
17 實質相同，未構成均等侵權。

18 (二)系爭產品3未落入系爭專利2請求項1至3、5至6、9至11、13
19 至14文義範圍，亦未落入系爭專利2請求項4、7、8、12、15
20 均等範圍：

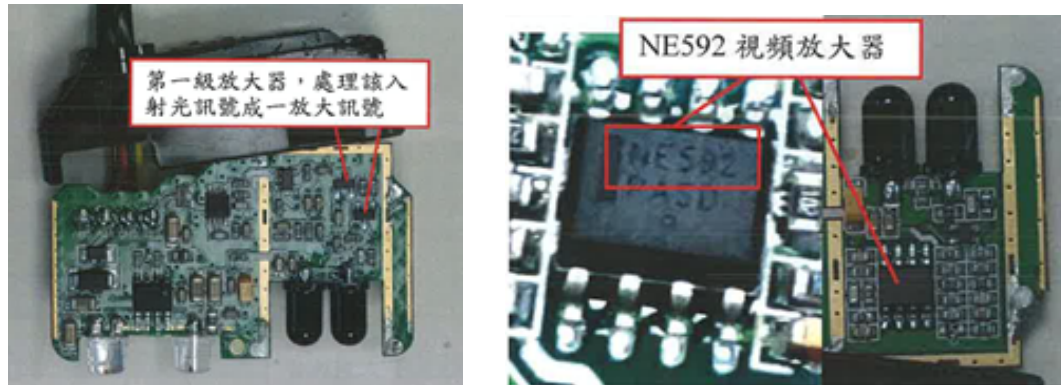
21 1.系爭產品3未落入系爭專利2請求項1之文義範圍：

22 (1)系爭專利2請求項1可解析為如前述1a至1g技術特徵。

23 (2)1a至1c技術特徵：系爭專利2請求項1之1a至1c技術特徵，
24 略同於系爭專利1請求項1之1A至1C技術特徵，而系爭產品
25 3具有系爭專利1請求項1之1A至1C技術特徵，已如前述，
26 故系爭產品3具有系爭專利2請求項1之1a至1c技術特徵。

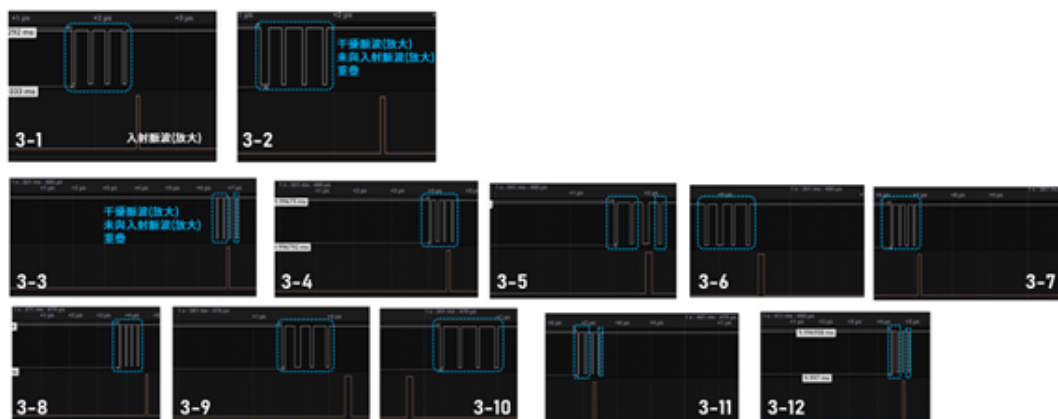
27 (3)1d技術特徵：系爭產品3於電路板上設有微控制器（型
28 號：ATmega32A，見本院卷三第628頁），與光接收器及光
29 發射器電性連接；系爭產品3另設有如下左圖所示第一級
30 放大器（本院卷三第638頁）與如下右圖所示視訊放大器
31 （型號：592，見本院卷三第640頁），有視訊放大器規格

書足憑（本院卷三第705至714頁）；又依系爭產品3之檢測結果，系爭產品3因應入射光訊號，會產生包括複數干擾脈波之干擾雷射光（見本院卷三第629頁），可知系爭產品3之微控制器會依據放大器經由光接收器所接收到的入射光訊號，驅動光發射器產生干擾雷射光，故系爭產品3具有1d技術特徵。

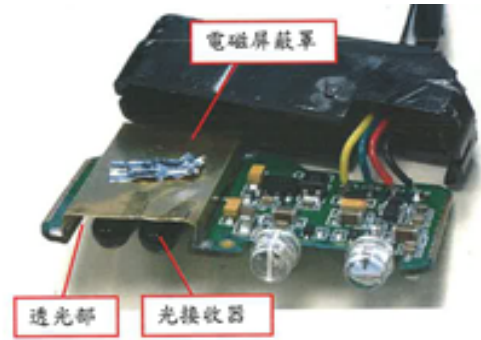


(4)1e技術特徵：觀之兩造會同鑑驗系爭產品3所得如下圖所示之波形圖（本院卷六第179頁），可知大部分之干擾脈波與入射脈波無任何重疊，與1e「該干擾雷射光之干擾脈波係與該入射雷射光之入射脈波至少部份重疊」之技術特徵不符，故系爭產品3未包含1e技術特徵。

系爭產品3 (HP-5 Plus) 檢測波形圖 (本院卷(六)第179頁)



(5)1f技術特徵：觀之下圖，系爭產品3之視訊放大器上方設有一電磁屏蔽罩，且該電磁屏蔽罩側邊可露出光接收器，相當於1f技術特徵之透光部（見本院卷三第630頁），是系爭產品3包含1f技術特徵。



(6)lg技術特徵：系爭產品3之光接收器連接於電路板上，且電磁屏蔽罩固定於該電路板之一側上（本院卷三第631頁），故系爭產品3包含lg技術特徵。

(7)綜上，系爭產品3雖具有系爭專利2請求項1之1a至1d、1f及lg技術特徵，然欠缺1e「該干擾雷射光之干擾脈波係與該入射雷射光之入射脈波至少部份重疊」之技術特徵。故系爭產品3就系爭專利2請求項1未構成文義侵權。

2.系爭產品3未落入系爭專利2請求項2、3、5、6、9至11、13、14之文義範圍：

系爭專利2請求項2、3、5、6、9至11、13、14係請求項1之直接或間接附屬項，均包含請求項1之全部技術特徵。如前述，系爭產品3未構成系爭專利2請求項1之文義侵權，則系爭產品3亦未構成系爭專利2請求項2、3、5、6、9至11、13、14之文義侵權。

3.系爭產品3未落入系爭專利2請求項4、7、8、12、15之均等範圍：

系爭專利2請求項4係請求項1之間接附屬項，具有請求項1之全部技術特徵。系爭專利請求項7、12係依附於請求項4、請求項8、15則依附於請求項7。原告主張因請求項7、8、12、15係直接或間接依附於請求項4，而請求項4之「該複數透孔與該複數光電二極體之受光頭端形狀概為對應」技術特徵雖未見於系爭產品3，但系爭產品3之電磁屏蔽罩之透光部可視為是複數個相連的透孔，故系爭產品3對請求項4、7、8、12、15構成均等侵權云云（本院卷三第647、648頁）。然查，系爭產品3之電磁屏蔽罩係呈「冂」字型，其側邊供光

01 電二極體露出處，並無任何可與受光頭端形狀對應之結構存
02 在，可知原告未就方式、功能與結果具體說明其構成均等侵
03 權之理由。且系爭產品3大部分之干擾脈波與入射脈波均不
04 重疊，與系爭專利2請求項1之1e「該干擾雷射光之干擾脈波
05 係與該入射雷射光之入射脈波至少部份重疊」之技術特徵，
06 具有實質差異，則系爭產品3對請求項4、7、8、12、15自未
07 構成均等侵權。

08 四、系爭產品1既未落入系爭專利1請求項1至7、11至13之文義範
09 圍、系爭專利1請求項8、10之均等範圍、系爭專利2請求項1
10 至3、5至6、9至11、13至14文義範圍、系爭專利2請求項4、
11 7、8、12、15均等範圍；系爭產品2既未落入系爭專利1請求
12 項1至7、11至13之文義範圍、系爭專利1請求項8、10之均等
13 範圍、系爭專利2請求項1至3、5至6、9至11、13至14文義範
14 圍、系爭專利2請求項4、7、8、12、15均等範圍；系爭產品
15 3既未落入系爭專利1請求項1至7、11至13之文義範圍、系爭
16 專利1請求項8、10之均等範圍、系爭專利2請求項1至3、5至
17 6、9至11、13至14文義範圍、系爭專利2請求項4、7、8、1
18 2、15均等範圍，是本件其餘爭點，即無逐一論駁之必要，
19 附此敘明。

20 柒、綜上所述，系爭產品並未落入系爭專利前開所述之請求項之
21 文義或均等範圍，則被告費西公司、超越群公司所製造或販
22 賣之系爭產品自無侵害原告系爭專利專利權之情事。從而，
23 原告依專利法第96條第1、3項、民法第185條、公司法第23
24 條第2項規定，請求被告等排除侵害、銷毀侵害系爭產品暨
25 連帶損害賠償及法定遲延利息，均為無理由，應予駁回。又
26 原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁
27 回。

28 捌、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經
29 本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附
30 此敘明。

01 訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1條，民事
02 訴訟法第78條。

03 中 華 民 國 113 年 7 月 31 日

04 智慧財產第三庭

05 法 官 王碧瑩

06 以上正本係照原本作成。

07 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提
08 出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

09 中 華 民 國 113 年 8 月 2 日

10 書記官 蔡文揚